



Rigaku

FY26 1Q 決算説明資料

リガク・ホールディングス株式会社

2026年5月13日

本資料には、当社または当社グループに関連する見通し、計画、目標などの将来に関する記述がなされています。これらの記述には、「予想」、「予測」、「予定」、「期待」、「意図」、「計画」、「可能性」やこれらの類義語が含まれることがありますが、これらに限られるものではありません。これらの将来に関する記述は、当社が現在入手している情報をもとに、本資料の作成時点における当社の判断に基づいて記載したものであり、また、一定の前提・仮定の下になされています。そのため、これらの記述または前提・仮定は、様々なリスクや不確定要素に左右され、実際の結果はこれと大幅に異なる可能性があります。

当社の現在の決算期は12月末であります。また、当社は、2022年1月1日を移行日として、2023年12月期より国際財務報告基準（以下「IFRS」といいます）を採用しております。

本資料には、研究開発費比率、設備投資額比率、フリーキャッシュ・フローなど、当社のNon-IFRS指標に関する記述がありますが、これらはIFRS、日本基準その他の会計基準に基づく財務数値に代替するものではありません。かかるNon-IFRS指標の当社における使用、定義および算定は、他社における同様の名称の財務指標とは大きく異なる可能性があり、直接的に比較することはできません。これらの財務数値の算出根拠等の詳細についてはAppendixをご参照ください。また、本資料には、製品区分別売上収益および営業利益並びにエンドマーケット別売上収益等の管理会計ベースの財務情報が含まれています。当該財務情報は日本基準またはIFRSに基づき作成されたものではなく、監査を受けたものでもありません。

本資料における記述は本資料の日付（またはそこに別途明記された日付）時点のものであり、当社は、それらの情報を最新のものに随時更新するという義務も方針も有しておりません。そのため、本資料に記載されている将来の見通しと実際の結果は必ずしも一致するものではありません。また、本資料に記載されている当社および当社グループ以外の企業等に関する情報は、公開情報または第三者が作成したデータ等から引用したものであり、かかる情報の正確性・適切性等について、当社は何らの検証も行っておらず、また、これを保証するものではありません。

なお、本資料における金額表記は億円未満を切り捨てて表示し、比率の数値は少数第2位を四捨五入して表示しています。

1. **Onto Innovationとの資本業務提携等について**
2. **中東情勢の影響について**
3. **FY26 1Q 連結決算概要**
4. **多目的分析機器事業アップデート**
5. **半導体プロセス・コントロール機器事業アップデート**
6. **FY26 業績見通し**

Onto Innovationとの 資本業務提携等について

Onto Innovation Inc.による 当社の株式取得、及び資本業務提携の概要

株式取得の概要

- 資本業務提携の一環として、米Onto Innovation Inc.（以下「Onto Innovation」）が、当社大株主であるAtom Investment, L.P.との間で、当社株式の取得を合意
 - 本株式取得の株式数／比率：61,123,436株／27.0%(1)
 - 株式取得時期（予定）：2026年下半期（関係当局の許認可取得等の手続きの完了後）

資本業務提携の概要

- 当社（以下「リガク」）とOnto Innovationの間で資本業務提携契約を締結
- 半導体プロセス・コントロール機器事業を軸としたリガクの成長戦略を直接的に強化
 - リガクのX線技術と、Onto Innovationの光学計測および解析ソフトウェアの技術を補完的に融合することで、次世代半導体に対応する計測ソリューションの高度化と事業領域の拡張を図る
 - 既に両社間にて、当社のCD-SAXSとOnto Innovationの解析ソフトウェアを組み合わせた、ハイブリッド計測ソリューションの共同開発を進めており、本資本業務提携により、当該取り組みをさらに発展・加速
- 顧客ニーズの高度化および半導体製造の複雑化が見込まれる市場環境に対応
 - 競争力の強化：半導体プロセス・コントロール分野における新たなポジションを確立
- リガクは安定的なパートナー関係のもとで上場会社としての経営の自主性・独立性を維持

注:

1: 2026年3月31日現在の発行済株式総数（自己株式を除く）に対する比率

資本業務提携の具体的な取り組み

1 X線技術 × 光学技術 の補完的な融合による「ハイブリッド計測ソリューションの実現」

- 高精度のX線と高速／高感度の光学を組み合わせ、微細化・三次元化が進むロジック・メモリ半導体への対応力を強化

2 先端パッケージング領域における事業拡大加速

- 需要が拡大する先端パッケージング向けの検査・計測分野への本格的な事業拡大／競争力強化

3 ソフトウェア・AIとの融合

- リガクの技術に、AIを活用したOnto Innovationの解析ソフトウェアを統合することで、計測、解析、プロセス最適化、歩留まり管理を含む一気通貫の統合ソリューションを構築

4 顧客基盤の拡張と製造・供給体制の高度化による競争力強化

- Onto Innovationのグローバルの顧客基盤を活用し、製品展開を加速

5 新市場創出に向けた取り組みの加速

- 協働体制の強化を通じて、2030年にリガク製品で少なくとも3億ドル規模の新市場創出を企図

中東情勢の影響について

中東情勢の影響について

- 現時点において、ビジネスへの直接的な影響は軽微であるが、継続して注視し、コスト増や在庫確保への対応を進める
 - 製品市場としての中東地域の影響は微小
 - 当社のイスラエルでの製造には問題無し。出荷は計画通り継続中
 - 現時点で原材料調達に影響は出ておらず、材料/物流コスト等への影響もなし
 - 主要部材の在庫はおよそ8月分まで確保
 - 年間の仕入額に占めるナフサ由来の部材は微小（全体の5%程度）
 - 今後、早期発注による資材の確保、生産・物流効率の向上、適切な価格への転嫁等により、調達リスクとコスト増に対応する

FY26 1Q 連結決算概要

FY26 1Q 連結決算ハイライト

全社

- 想定通りの端境期ではあるが、半導体プロセス・コントロール機器の堅調により、想定を上回る業績達成
- 2Q以降の成長に手応えあり。パイプラインは順調に進捗(前年同期比+11%)、足元の受注予測は堅調
- 中東情勢の影響は現時点では軽微であるが、継続して注視し、コスト増、在庫確保への対応を進める

多目的 分析機器

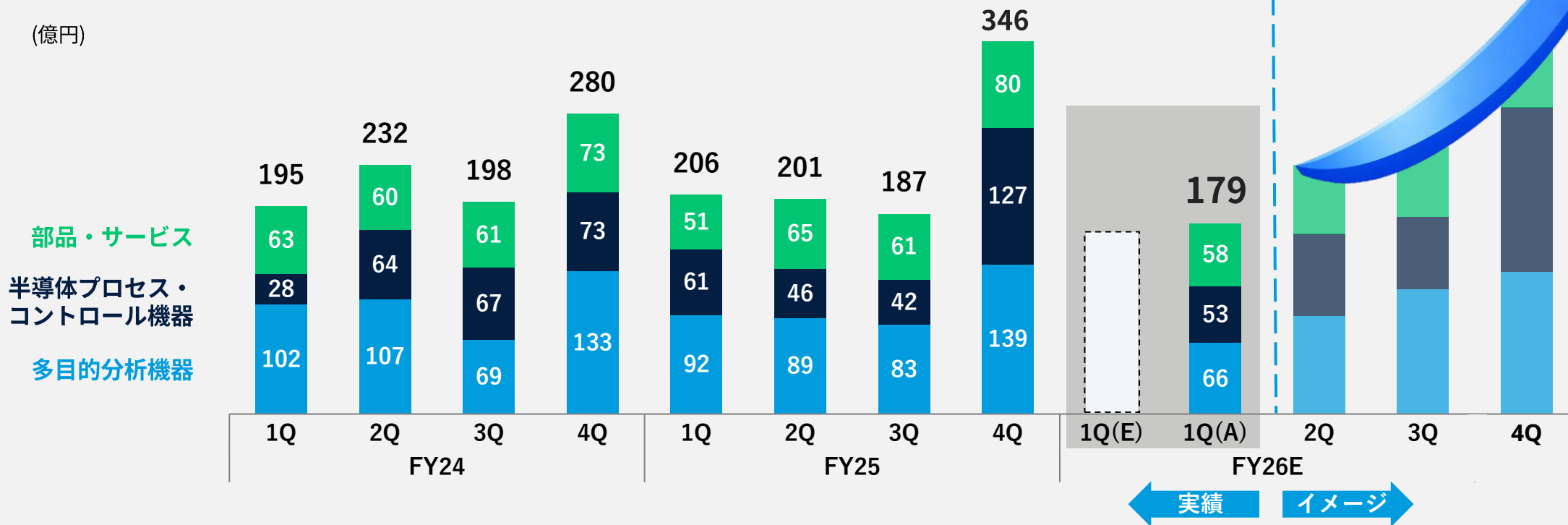
- 米国でのトランプ政策影響は継続。日本/中国はほぼ想定どおりに堅調なるも、全体として前年同期比で売上収益、営業利益ともに減少
- 半導体/電子部品向け需要やMI/自動化材料探索等の需要は高まっており、2Q以降の成長に向けた案件は増大

半導体 プロセス・ コントロール 機器

- メモリ、ロジックにおける需要の高まりを捕捉し、売上収益、営業利益ともに想定を上回る
- 2Q以降もメモリ・ロジックを中心にした需要拡大や案件の前倒し等で成長が加速する見込み。新製品案件も順調に進捗

カテゴリ別売上収益推移（四半期）

- 1Q売上収益は想定を上回り着地
- 足元では半導体プロセス・コントロール機器事業のメモリ・ロジックの旺盛な需要、多目的分析機器事業は新製品の上市もあり、2Q以降の回復に向けて順調に進捗
- 3Q以降も期初計画通りYoYで増収基調が続く見込み



※ Noto Sans JP 9pt：注釈が入ります。

FY26 1Q 連結業績サマリー (YoY)

(億円)	FY25 1Q	FY26 1Q	前年同期比
売上収益	206	179	-13.0%
営業利益	28	6	-77.8%
営業利益率(%)	13.8%	3.5%	-10.2pt
税引前利益	27	4	-85.3%
四半期利益 ⁽¹⁾	19	3	-82.8%
基本的EPS(円)	8.52	1.46	-
EBITDA	40	20	-49.6%
EBITDA率(%)	19.6%	11.3%	-8.2pt

- 売上収益及び営業利益は、半導体プロセス・コントロール機器の牽引により、それぞれ想定を上回る

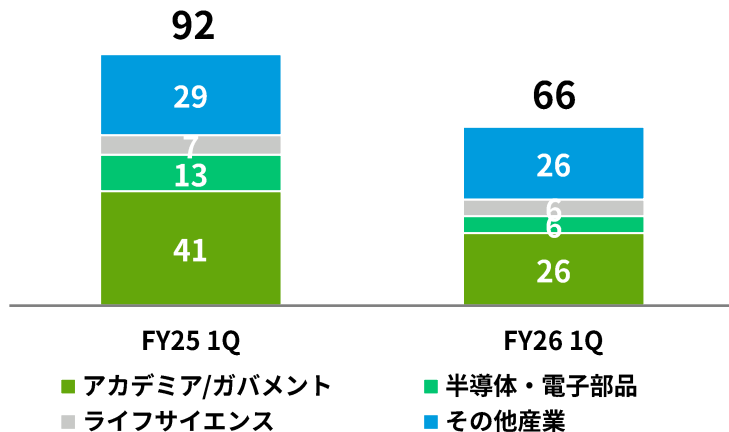
注:

1. 親会社の所有者に帰属する四半期利益に読み替え

FY26 1Q カテゴリー別業績サマリー

多目的分析機器

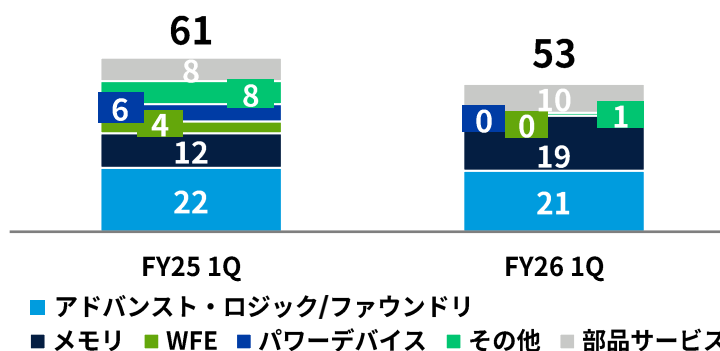
(億円)	FY25 1Q	FY26 1Q	YoY
売上収益	92	66	-27.7%
営業利益	12	-2	N/A
利益率 (%)	13.6%	-4.0%	-17.6pt



- 米国でのトランプ政策影響等により、アカデミア比率が減少
- 粗利率はコスト増のある中、ミックスの改善で前年同期並みを維持

半導体プロセス・コントロール機器

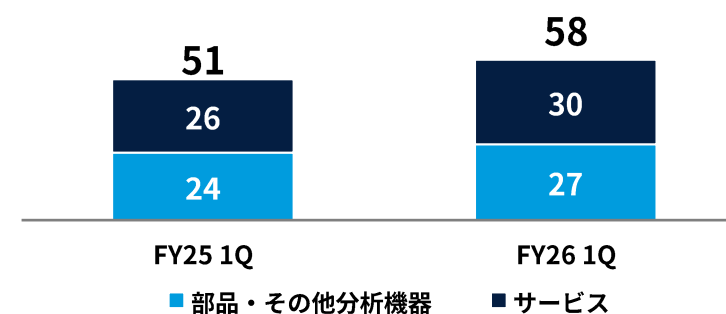
(億円)	FY25 1Q	FY26 1Q	YoY
売上収益	61	53	-13.1%
営業利益	16	5	-64.0%
利益率 (%)	26.3%	10.9%	-15.4pt



- メモリ、ロジックは前年同期比でも堅調
- 営業利益は、前年同期比で減少するも、売上が伸びたことで想定を上回る

部品・サービス

(億円)	FY25 1Q	FY26 1Q	YoY
売上収益	51	58	+13.2%
営業利益	5	10	+76.2%
利益率 (%)	11.2%	17.4%	+6.2pt



- 売上、営業利益ともに、前年同期比および想定を上回る
- EUVの低需要が続く中、サービス(値上げ、拡販施策等の効果)とその他分析機器・部品販売が伸長し、増収と利益増に寄与

多目的分析機器事業 アップデート

Pillar3製品の用途拡大

- 市場環境の変化：化合物半導体（SiC）のウエハ300mm化、300mmシリコンウエハ向け需要（DRAM）の台頭、GaN等新素材開発も加速
- 製品ラインアップをR&D（Lab）から量産（Fab）へ拡充。26年の需要拡大へ対応（24年ブームの再現を目指せる環境）

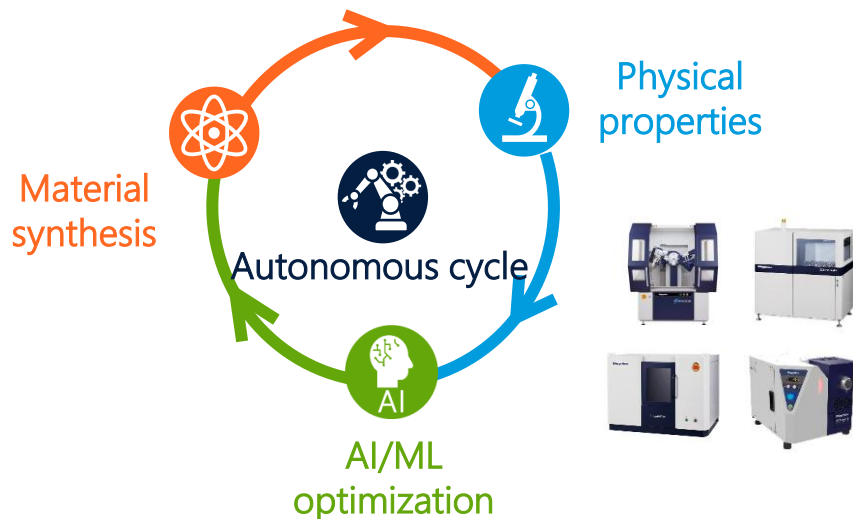


高分解能X線トポグラフィーにより、ウエハ全体の高速・高信頼・非破壊検査を実現
Near-Fab／Fab製品を品質管理用途で展開し、2025年9月より販売開始



**Qualana
(μEDX Solutions)**

- 電子回路／PCB向けの微小部元素分析
- 国内外大手産業顧客から引き合い旺盛



LabLinc Studio

- R&Dにおける「合成⇄測定⇄学習」のクローズドループ型システム
- 材料探索・最適化の高速化を実現
- GENESIS Mission⁽¹⁾による需要拡大を捉え、XRD/XRF/CT等多分野分析装置をつなぐLabLinc Studioを開発



CT Lab HR160



CT Lab HV

- 産業用CTのポートフォリオ強化
 - ✓ HR160：業界トップクラスの高分解能を有する産業用CT、電子部品開発/PCBの欠陥分析に活用
 - ✓ HV：高電圧・大型サンプル対応、電池欠陥分析等で採用

注：

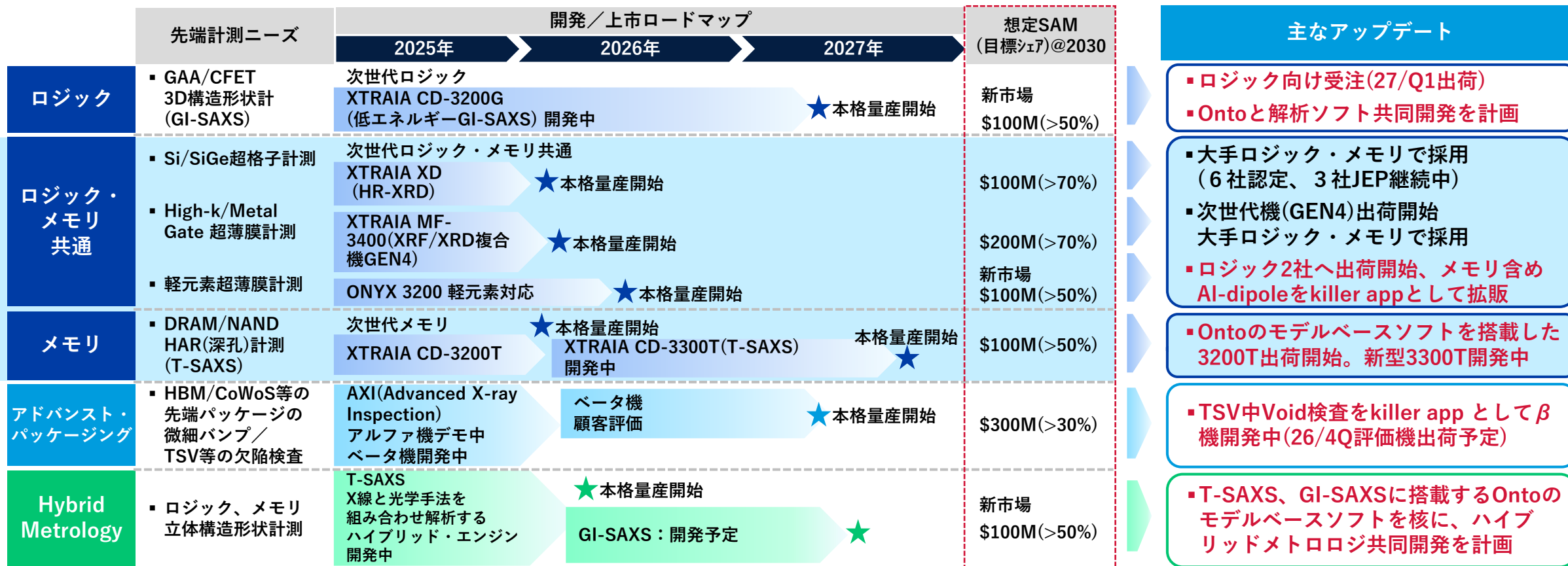
1. AIを活用し、米国の科学研究の生産性を飛躍的に向上させる官民連携プロジェクト（米国エネルギー省（DOE）主導、国立研究所・大学・企業が参画）

半導体プロセス・コントロール 機器事業アップデート

新製品ロードマップ

市場と目標

- 次世代の半導体の開発・量産向けに新製品群をタイムリーに上市
- 新製品の想定SAM計 約10億ドルに対して、当社目標シェア50%以上
- 2030年売上収益目標：既存製品とあわせて1,000億円を視野に入れ、Ontoとの資本業務提携を推進

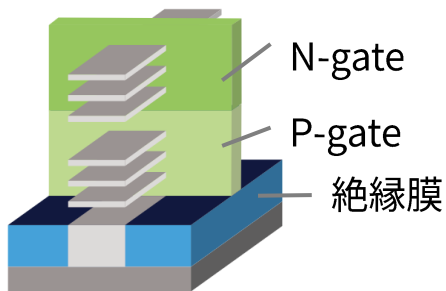


世界最高水準の研究基盤を活用した開発加速

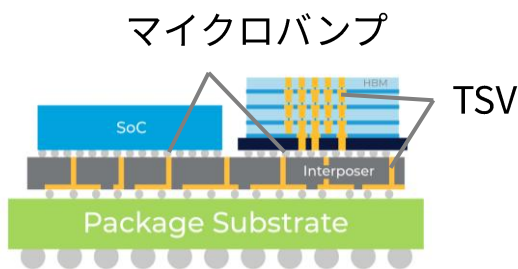
- 次世代半導体デバイスの高度なニーズに応えるべく、高付加価値で差別化された計測ソリューションを開発

先端ロジック

CFETデバイス向け計測・検査技術



先端パッケージング向け 非破壊検査技術

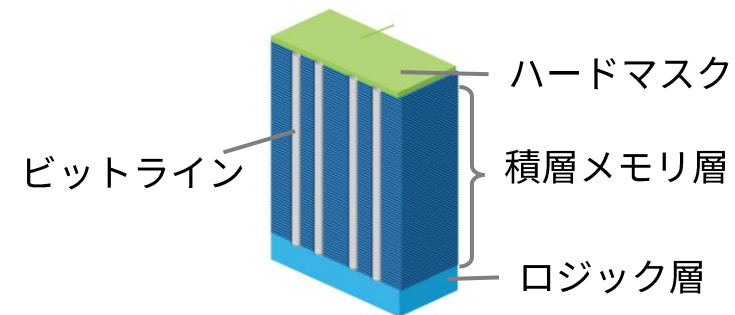


アドバンスド・パッケージング

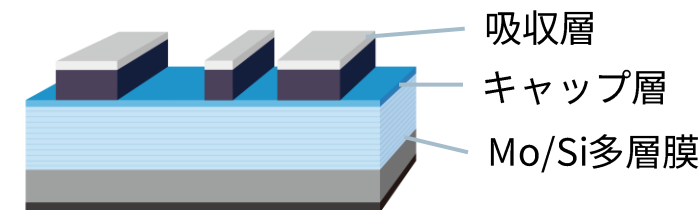
新たな3年間の開発プログラムを締結し、3Dデバイス計測、極薄膜・微量元素の高感度検出、微小欠陥の非破壊検査などのコアX線技術をさらに高度化

先端メモリ (3D DRAM)

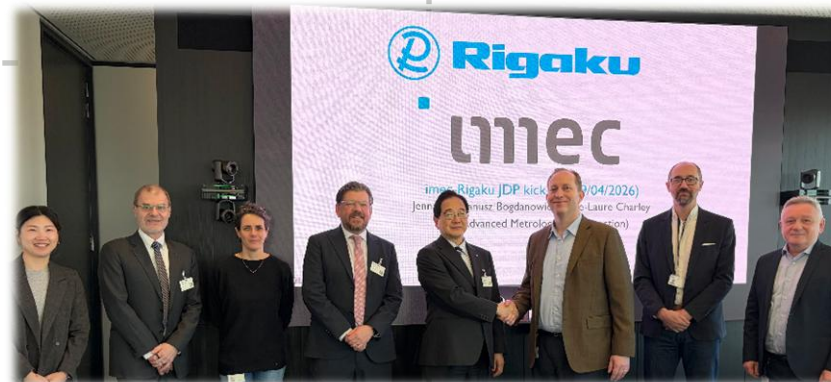
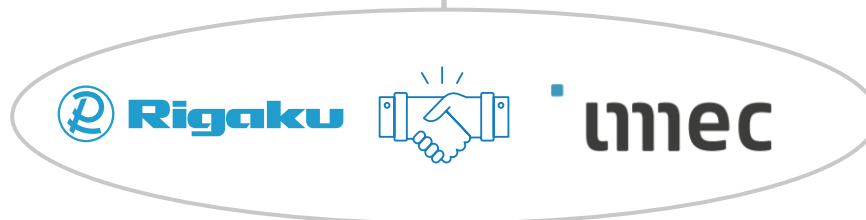
3DDRAMにおけるナノ構造の評価



EUVフォトマスクの劣化評価



フォトマスク



リガクが目指す技術革新：Hybrid Metrology

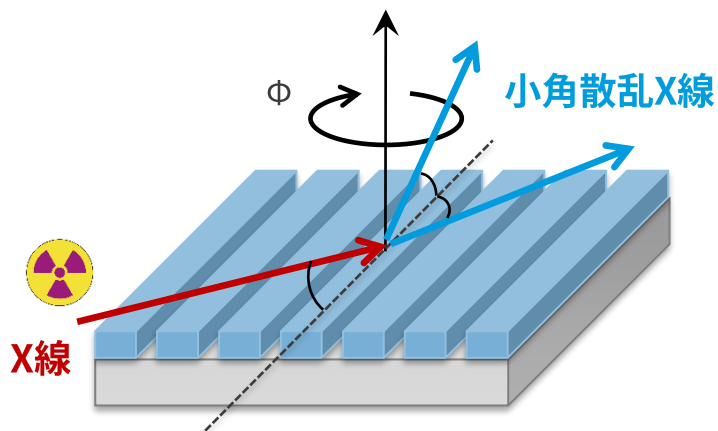
■ Hybrid Metrology: 各計測手法の長所を生かした高精度・高効率計測の実現を目指す

- X線波長(10^{-10}m)に基づく高精度計測
- デバイス深部までの高精度計測

X-Ray

OCD⁽¹⁾・
SEM・
Ellipsometers

- 高スループット
- 豊富なライブラリに基づく品質管理に好適なMetrology



計測対象



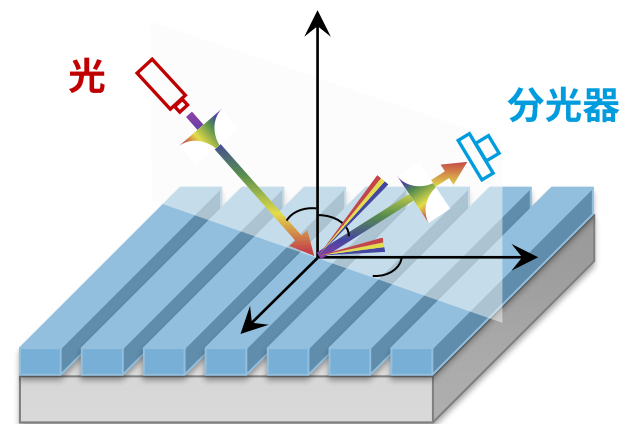
Output

Output

ハイブリッドエンジン
(物理モデル+機械学習)

高精度・高スループットな計測結果

- 既参入領域でのシェア拡大加速
- 新規ニーズ獲得による未参入領域進出



注：
1. Optical Critical Dimension
2. PDN = Power Delivery Network

FY26 連結業績見通し

FY26 連結業績見通し - 変更なし

(億円)	FY25	FY26 ⁽²⁾	前期比
売上収益	941	1,010	+7.2%
営業利益	167	194	+16.1%
営業利益率(%)	17.7%	19.3%	+1.6pt
税引前利益	159	184	+15.2%
当期利益 ⁽¹⁾	114	125	+9.6%
基本的EPS(円)	50.19	55.27	-
EBITDA	218	253	+15.8%
EBITDA率(%)	23.2%	25.0%	+1.8pt

注：

1. 親会社の所有者に帰属する当期利益に読み替え

2. 対米ドル為替感応度：売上収益約2億円、営業利益約0.4億円(米国子会社からのドル建て借入金にかかる評価損益を含む)、対ユーロ為替感応度：売上収益約0.7億円、営業利益約0.3億円

3. 前年度と同等の為替で比較した場合

全社

- 売上収益は実質 +9%⁽³⁾で中期経営計画並みの成長
- 粗利率拡大でR&Dを含む販管費の増加を吸収し、EBITDAマージン/営業利益率/当期利益率を向上させる戦略は不変
- 引き続き2027年度に中計の目標達成を目指す

多目的分析機器

- 米アカデミア市場の急速な回復を前提としないものの、市場全体は安定成長に回帰するなかで実質 +4%⁽³⁾成長を計画
 - 米州と中国で増収、日本・欧州は前年並みを確保
 - インダストリー向け拡大でアカデミア向け減収を吸収
 - 製品ミックスの改善、価格政策により売上成長とGM率改善

半導体プロセス・コントロール機器

- AI用途の半導体の旺盛な需要を背景に実質 +21%⁽³⁾成長
- 新製品は2.2倍増、AI用途比率は71%へ
- 新製品の貢献拡大により粗利率は2.0pts向上

■ 1Q業績は想定を上回る

- 半導体プロセス・コントロール機器事業でメモリ・ロジック需要の高まりを捕捉
- 年間見通しは変更せず：多目的分析機器事業の回復タイミング、中東情勢の影響に注視

■ 事業成長や経営の方向感としては短期/中期ともに大きく進捗

- 短期：2Q業績回復に向けて順調に進捗、計画通り通年での前年比増収増益を見込む
- 中期：Onto Innovationとの資本業務提携により中期成長の蓋然性向上 & 安定性の増した株主構成のもと、さらなる成長に向けて一歩踏み出す

Appendix

- 米国を拠点とする、半導体業界向けのプロセス制御ソリューションのリーディングプロバイダー
- 光学技術を得意とし、欠陥検査・計測ツールや分析ソフトウェア等の製造・販売を手掛ける

会社概要

会社名	Onto Innovation Inc.		
代表者	Michael P. Plisinski (Chief Executive Officer)		
上場取引所	ニューヨーク証券取引所 (NYSE: ONTO)		
主要財務 (FY25/12)	Revenue:	\$1,005MM	
	Non-GAAP営業利益:	\$255MM	
	Cash:	\$640MM	
時価総額	\$14.5Bn (2026年4月17日時点)		
本社所在地	マサチューセッツ州ウィルミントン (米国)		
従業員数	1,615名		
事業概要	グローバルの主要半導体メーカー向けに、半導体製造プロセス全体における品質・生産性向上を支える検査・計測、データ解析ソリューションを提供。先端パッケージング領域にも強み		

製品／ソリューション

Inspection (検査)

前工程～先端パッケージ向け
欠陥検査

ウエハ／パネル表面
の欠陥・異常検出

歩留まり改善・
量産ライン安定化



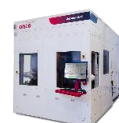
Dragonflyシリーズ
(先端パッケージ向け欠陥検査装置)

Lithography (露光)

パッケージ含む次世代露光制御

パターンニング工程の
形成・制御

量産立上げ加速・
工程窓の拡大



JetStepシリーズ
(先端パッケージ向けリソグラフィ装置)

Metrology (計測)

微細構造・材料特性の精密計測

膜厚／形状／構造を
定量化

工程条件最適化・
微細化対応を実現



Atlasシリーズ
(Optical Critical Dimension及び薄膜計測)

Analytics Software

検査・計測データを統合可能な
解析ソフト

検査・計測データを
横断的に統合／可視化

開発～量産の意思
決定プロセス最適化

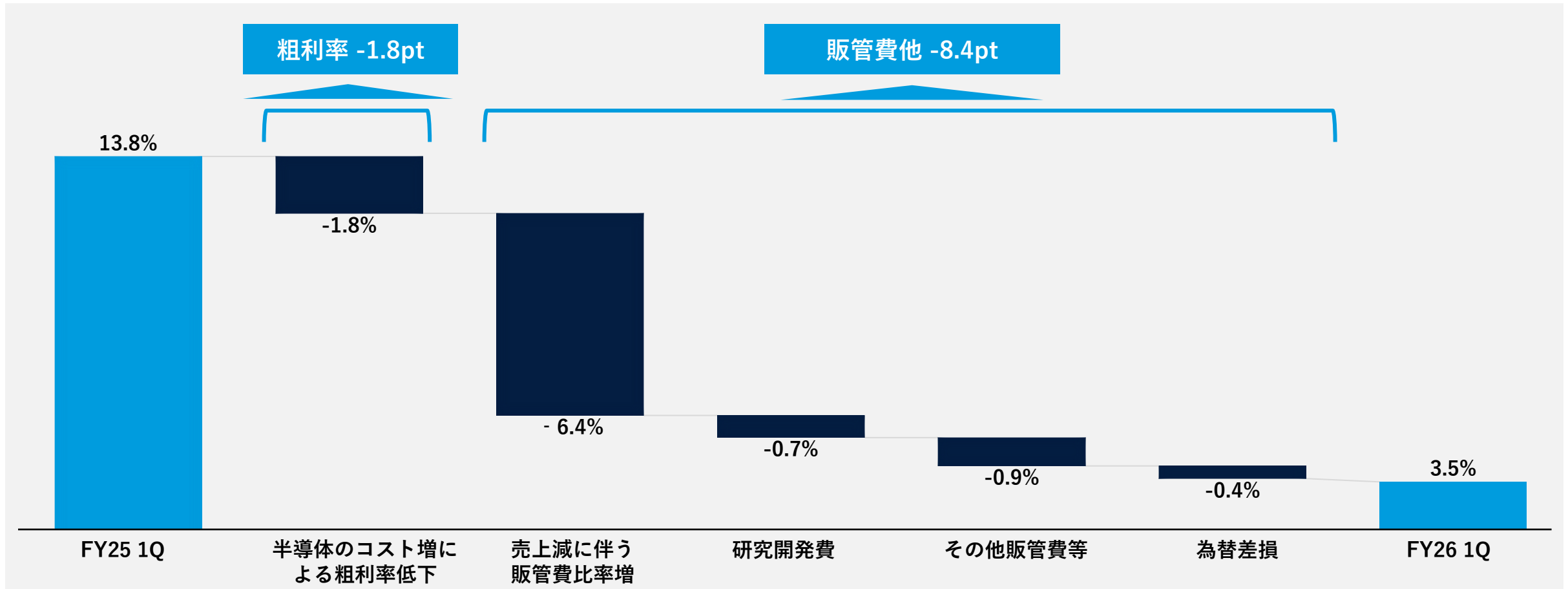


Discoverシリーズ
(工程データを横断解析するソフトウェア)

FY26 1Q 連結営業利益要因分析 (YoY)

■ 営業利益率 3.5% 前年同期比 10.2pt減

- 粗利率は主に半導体における納入コスト増、資材費高騰等による粗利益率の低下
- 売上減に加え、継続した戦略投資により、研究開発費と販管費（主に人件費）の割合が増加
- 為替差損は、急激な円安によるグループ内ドル建て借入金等の評価損が影響



FY26 1Q カテゴリー別業績サマリー（地域別売上収益）

多目的分析機器

半導体プロセス・コントロール機器

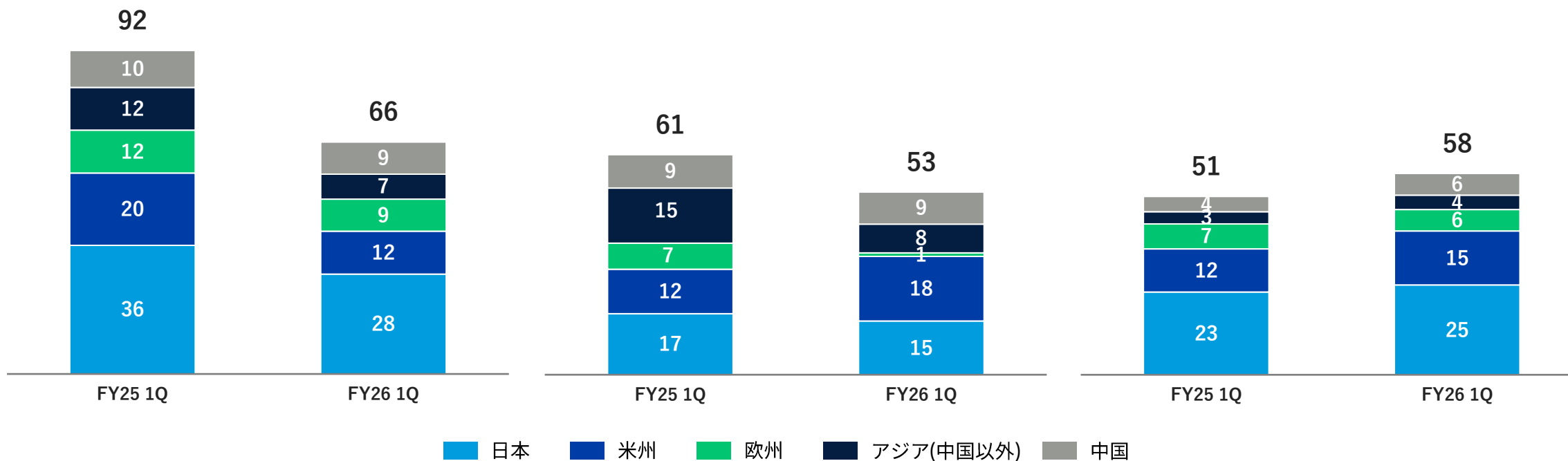
部品・サービス

(億円)

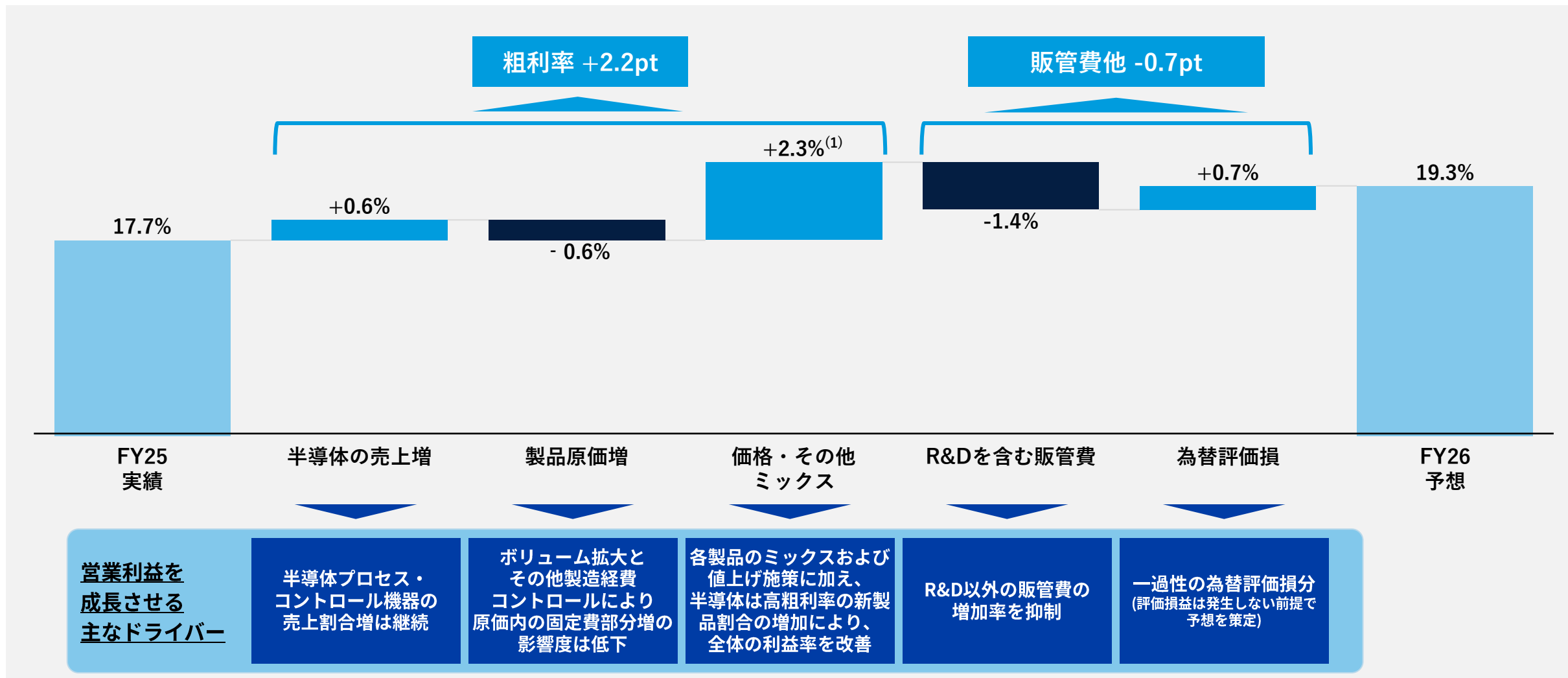
	FY25 1Q	FY26 1Q	YoY
売上収益	92	66	-27.7%
営業利益	12	-2	N/A
利益率(%)	13.6%	-4.0%	-17.6pt

	FY25 1Q	FY26 1Q	YoY
売上収益	61	53	-13.1%
営業利益	16	5	-64.0%
利益率(%)	26.3%	10.9%	-15.4pt

	FY25 1Q	FY26 1Q	YoY
売上収益	51	58	+13.2%
営業利益	5	10	+76.2%
利益率(%)	11.2%	17.4%	+6.2pt



FY26 業績予想 vs FY25 実績 営業利益要因分析



注：

1. +0.3%相当のサービス技術サポート費用の原価から販管費への変更含む

製品別損益 (管理会計ベース) (1)

(10億円)/(JPY Bn)	FY25					FY26					Est.
	1Q	2Q	3Q	4Q	Full-year	1Q	2Q	3Q	4Q	Full-year	
多目的分析機器/Multipurpose Analytical Instruments											
売上収益/Revenue	9.2	8.9	8.3	13.9	40.4	6.6	-	-	-	-	41.5
営業利益/Operating Profit	1.2	1.3	0.4	3.1	6.2	-0.2	-	-	-	-	6.2
営業利益率/Operating Margin	13.6%	15.0%	5.4%	22.7%	15.4%	-4.0%	-	-	-	-	14.9%
半導体プロセス・コントロール機器/Semiconductor Process Control Instruments											
売上収益/Revenue	6.1	4.6	4.2	12.7	27.8	5.3	-	-	-	-	33.3
営業利益/Operating Profit	1.6	0.8	-0.0	5.6	8.0	0.5	-	-	-	-	10.4
営業利益率/Operating Margin	26.3%	17.9%	-1.9%	44.7%	29.0%	10.9%	-	-	-	-	31.4%
部品・サービス/Components and Services											
売上収益/Revenue	5.1	6.5	6.1	8.0	25.9	5.8	-	-	-	-	26.0
営業利益/Operating Profit	0.5	1.5	1.1	1.8	5.1	1.0	-	-	-	-	4.7
営業利益率/Operating Margin	11.2%	23.3%	19.0%	23.2%	19.8%	17.4%	-	-	-	-	18.3%
連結合計/Consolidated Total											
売上収益/Revenue	20.6	20.1	18.7	34.6	94.1	17.9	-	-	-	-	101
営業利益/Operating Profit	2.8	2.8	0.8	10.1	16.7	0.6	-	-	-	-	19.4
営業利益率/Operating Margin	13.8%	14.3%	4.5%	29.2%	17.7%	3.5%	-	-	-	-	19.3%

注:

1. 本情報は、投資家の皆さまの理解のために参考情報として作成したものであり、本社費を加味していないため、連結営業利益は各カテゴリーの合計値と一致しません

地域別、エンドマーケット別売上収益

地域別売上収益

(10億円)/(JPY Bn)	FY25					FY26				
	1Q	2Q	3Q	4Q	Full-year	1Q	2Q	3Q	4Q	Full-year
日本/Japan	7.7	4.1	4.8	10.7	27.4	6.9	-	-	-	-
米州/Americas	4.5	5.9	4.0	8.9	23.4	4.6	-	-	-	-
欧州/EMEA	2.7	3.8	2.6	4.6	13.8	1.7	-	-	-	-
アジア(中国以外)/Asia (ex. China)	3.1	3.0	3.7	6.9	16.8	2.0	-	-	-	-
中国/China	2.3	3.2	3.4	3.5	12.5	2.5	-	-	-	-
売上収益合計/Total Revenue	20.6	20.1	18.7	34.6	94.1	17.9	-	-	-	-

エンドマーケット別売上収益

(10億円)/(JPY Bn)	FY25					FY26				
	1Q	2Q	3Q	4Q	Full-year	1Q	2Q	3Q	4Q	Full-year
半導体・電子部品/ Semiconductor/Electronic Components	7.7	6.1	4.9	14.3	33.3	6.0	-	-	-	-
ライフサイエンス/Life Science	0.9	0.8	1.3	1.9	5.0	0.8	-	-	-	-
その他産業/Other Industries	3.4	3.5	3.5	5.1	15.7	3.4	-	-	-	-
アカデミア&ガバメント/ Academia/Governments	4.6	5.9	5.1	9.1	24.8	3.1	-	-	-	-
サービス/Services	3.7	3.6	3.7	4.1	15.1	4.4	-	-	-	-
売上収益合計/Total Revenue	20.6	20.1	18.7	34.6	94.1	17.9	-	-	-	-

連結 四半期業績



(10億円)/(JPY Bn)	FY2025					FY2026					予想
	1Q	2Q	3Q	4Q	Full-year	1Q	2Q	3Q	4Q	Full-year	Full-year
売上収益/Revenue	20.6	20.1	18.7	34.6	94.1	17.9	-	-	-	-	101.0
売上総利益 ⁽¹⁾ /Gross Profit ⁽¹⁾	11.5	11.1	9.7	20.4	52.8	9.7	-	-	-	-	58.9
営業利益/Operating Profit	2.8	2.8	0.8	10.1	16.7	0.6	-	-	-	-	19.4
税引前利益/Profit Before Taxes	2.7	2.7	0.6	9.8	15.9	0.4	-	-	-	-	18.4
当期利益/Net Profit	1.9	1.8	0.4	7.1	11.4	0.3	-	-	-	-	12.5
EPS (円) /EPS (JPY)	8.52	8.19	2.10	31.38	50.19	1.46	-	-	-	-	55.27
Non-IFRS Indicator											
調整後営業利益/Adjusted Operating Profit	3.3	3.3	1.3	10.6	18.6	1.1	-	-	-	-	21.5
調整後当期利益/Adjusted Net Profit	2.2	2.1	0.8	7.4	12.7	0.6	-	-	-	-	13.9
調整後EPS (円) /Adjusted EPS (JPY)	-	-	-	-	55.19	-	-	-	-	-	61.40
EBITDA	4.0	4.1	2.1	11.5	21.8	2.0	-	-	-	-	25.3
調整後EBITDA/Adjusted EBITDA	4.0	4.0	2.1	11.4	21.7	2.0	-	-	-	-	25.3
対売上収益比率/Adjusted EBITDA Margin	19.6%	20.0%	11.7%	33.0%	23.0%	11.3%	-	-	-	-	25.1%
ROE	-	-	-	-	13.4%	-	-	-	-	-	13.5%
調整後ROE/Adjusted ROE	-	-	-	-	14.9%	-	-	-	-	-	15.0%
研究開発費/R&D Expenses	1.6	1.8	1.8	1.9	7.3	1.7	-	-	-	-	8.5
設備投資額/CAPEX	0.6	3.4	1.0	1.5	6.6	1.0	-	-	-	-	7.7
減価償却費/Depreciation	1.2	1.2	1.3	1.3	5.1	1.4	-	-	-	-	5.8
JPY/USD	151.2	147.5	147.8	149.8	149.8	156.5	-	-	-	-	145.0
JPY/EURO	159.4	162.2	165.6	169.5	169.5	183.5	-	-	-	-	165.0

注: FY25 Q1の売上総利益は、FY26の費用構造に合わせて一部費用の分類を変更したことに伴い、再表示しております。そのため、当初開示した数値とは異なります。なお、FY25 Q2以降については、FY26と同様の分類を適用しております。

FY26 1Q B/S & キャッシュ・フロー

B/S

(10億円)/(JPY Bn)	FY25 Year-end	FY26 1Q	Changes
流動資産/Current Assets	76.2	73.2	-3.0
現預金/Cash and Cash Equivalents	24.2	25.6	1.4
棚卸資産/Inventories	20.8	23.7	2.9
営業債権、その他流動資産など/ Trade Receivables, Other Current Assets, etc.	31.1	23.7	-7.3
非流動資産/Non-Current Assets	108.9	109.2	0.3
有形固定資産/Property, Plant & Equipment	22.6	23.1	0.5
のれん、無形資産など/Goodwill, Intangible Assets, etc.	86.3	86.0	-0.2
資産合計/Total Assets	185.2	182.4	-2.7

(10億円)/(JPY Bn)	FY25 Year-end	FY26 1Q	Changes
負債/Liabilities	96.8	95.0	-1.7
有利子負債/Interest-Bearing Debt	62.1	64.3	2.1
その他負債/Other Liabilities	34.6	30.6	-3.9
資本合計/Total Equity	88.3	87.4	-0.9
負債・資本合計/Total Liabilities and Equity	185.2	182.4	-2.7

キャッシュ・フロー

(10億円)/(JPY Bn)	FY25 1Q	FY26 1Q	Changes
営業キャッシュ・フロー/Operating Cash-Flow	1.1	2.2	1.1
投資キャッシュ・フロー/Investing Cash-Flow	-0.6	-1.0	-0.4
フリーキャッシュ・フロー/Free Cash-Flow	0.4	1.2	0.7
財務キャッシュ・フロー/Financing Cash-Flow	-3.0	-0.0	2.9
為替換算差異/Impact on Exchange Rate	-1.1	0.2	1.4
ネットキャッシュ・フロー/Net Cash-Flow	-3.7	1.4	5.1

財務指標

	FY25 Year-end	FY26 1Q	Changes
ネットデット ÷ 調整後EBITDA ⁽¹⁾ / Net Debt / Adjusted EBITDA ⁽¹⁾	1.7x	2.0x	-
自己資本比率/Equity Ratio	47.7%	47.9%	-

注：

1. 2025年12月期末の値はLTM合計の調整後EBITDAを用いて算出

調整後利益等における調整項目(1/2)

(10億円)/(JPY Bn)

EBITDA	FY25					FY26				予想
	1Q	2Q	3Q	4Q	Full-year	1Q	2Q	3Q	4Q	Full-year
税引前利益/Profit Before Taxes	2.7	2.7	0.6	9.8	15.9	0.4	-	-	-	18.4
減価償却費及び償却費/Depreciation and Amortization	1.2	1.2	1.3	1.3	5.1	1.4	-	-	-	5.8
支払利息/Interest Expenses	0.2	0.2	0.2	0.3	1.1	0.2	-	-	-	1.5
受取利息及び配当金/Interest and Dividend Income	-0.1	-0.1	-0.1	-0.0	-0.4	-0.0	-	-	-	-0.4
減損損失/Impairment Losses	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0
EBITDA	4.0	4.1	2.1	11.5	21.8	2.0	-	-	-	25.3
利益率/Margin	19.6%	20.4%	11.7%	33.2%	23.2%	11.3%	-	-	-	25.0%

調整後EBITDA	1Q	2Q	3Q	4Q	Full-year	1Q	2Q	3Q	4Q	Full-year
EBITDA	4.0	4.1	2.1	11.5	21.8	2.0	-	-	-	25.3
コンサルティング・フィー/Business Consulting Fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
中国免除申請関連費用/China-related exemption application costs	-	-0.0	-	-0.0	-0.1	-	-	-	-	0.0
調整項目計/Total Adjustments	-	-0.0	-	-0.0	-0.1	-	-	-	-	0.0
調整後EBITDA/Adjusted EBITDA	4.0	4.0	2.1	11.4	21.7	2.0	-	-	-	25.3
利益率/Margin	19.6%	20.0%	11.7%	33.0%	23.0%	11.3%	-	-	-	25.0%

調整後利益等における調整項目(2/2)

(10億円)/(JPY Bn)	FY25					FY2026					予想
	1Q	2Q	3Q	4Q	Full-year	1Q	2Q	3Q	4Q	Full-year	
調整後営業利益/Adjusted Operating Profit											
営業利益/Operating Profit	2.8	2.8	0.8	10.1	16.7	0.6	-	-	-	19.4	
PPA償却費/PPA Amortization	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	0.5	-	-	-	2.1	
コンサルティング・フィー/Business Consulting Fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	
中国免除申請関連費用/China-related exemption application costs	-	-0.0	-	-0.0	-0.1	-	-	-	-	0.0	
減損損失/Impairment Losses	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0	
調整項目計/Total Adjustments	0.5	0.4	0.5	0.4	1.9	0.5	-	-	-	2.1	
調整後営業利益/Adjusted Operating Profit	3.3	3.3	1.3	10.6	18.6	1.1	-	-	-	21.5	
利益率/Margin	16.3%	16.5%	7.2%	30.6%	19.8%	6.4%	-	-	-	21.3%	

	1Q	2Q	3Q	4Q	Full-year	1Q	2Q	3Q	4Q	Full-year
調整後当期利益/Adjusted Profit										
当期利益/Profit	1.9	1.8	0.4	7.1	11.4	0.3	-	-	-	12.5
PPA償却費/PPA Amortization	0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	0.5	-	-	-	2.1
コンサルティング・フィー/Business Consulting Fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
中国免除申請関連費用/China-related exemption application costs	-	-0.0	-	-0.0	-0.1	-	-	-	-	0.0
減損損失/Impairment Losses	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	0.0
調整項目計/Total Adjustments	0.5	0.4	0.5	0.4	1.9	0.5	-	-	-	2.1
調整項目に対する税金等調整/Tax Adjustments to Total Adjusted Items	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.6	-0.1	-	-	-	-0.7
調整後当期利益/Adjusted Profit	2.2	2.1	0.8	7.4	12.7	0.6	-	-	-	13.9
利益率/Margin	11.0%	10.7%	4.5%	21.5%	13.5%	3.8%	-	-	-	13.8%

Rigaku at a Glance

会社概要

- 75年のイノベーションの歴史を持つ、先端X線技術のグローバルリーダー
- 高度な研究開発力により、業界トップクラスの収益性を実現
- 半導体プロセス・コントロール分野の20%超の成長により高いEBITDAマージンと持続的な成長を実現

高い成長力と収益性を兼ね備えた財務プロファイル (2025年12月期)

売上収益
941億円

EBITDA⁽²⁾
218億円
(マージン23.0%)

半導体プロセス・コントロール機器事業
売上収益CAGR⁽¹⁾
21%

海外売上収益比率⁽³⁾
71%

半導体前工程向け
X線計測機器シェア⁽⁶⁾
グローバル No.1

X線回折機器 (XRD)
シェア⁽⁴⁾⁽⁵⁾
グローバル No.2
国内 No.1

注:

1. 2023年12月期から2025年12月期までの3年間におけるCAGR

2. EBITDA=税金等調整前当期利益+減価償却費及び償却費+減損損失-受取利息及び配当金+支払利息

3. 海外の顧客・代理店に対する売上収益に基づき算出

4. Strategic Directions International, Inc. [SDi Global Assessment Report 2025]

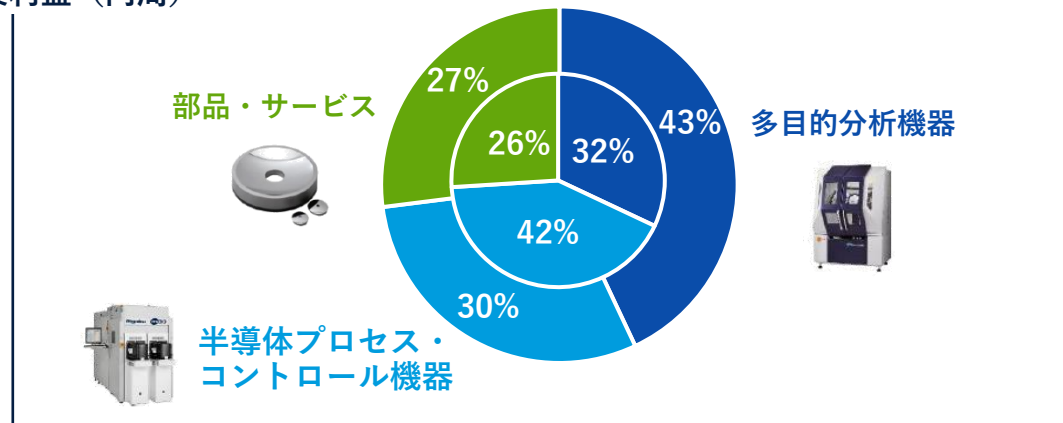
5. 株式会社アールアンドディ「科学機器年鑑 2025年版」

6. Yole Intelligence「2026 Yole Group Japan Visits - The Semiconductor Industry Trends」

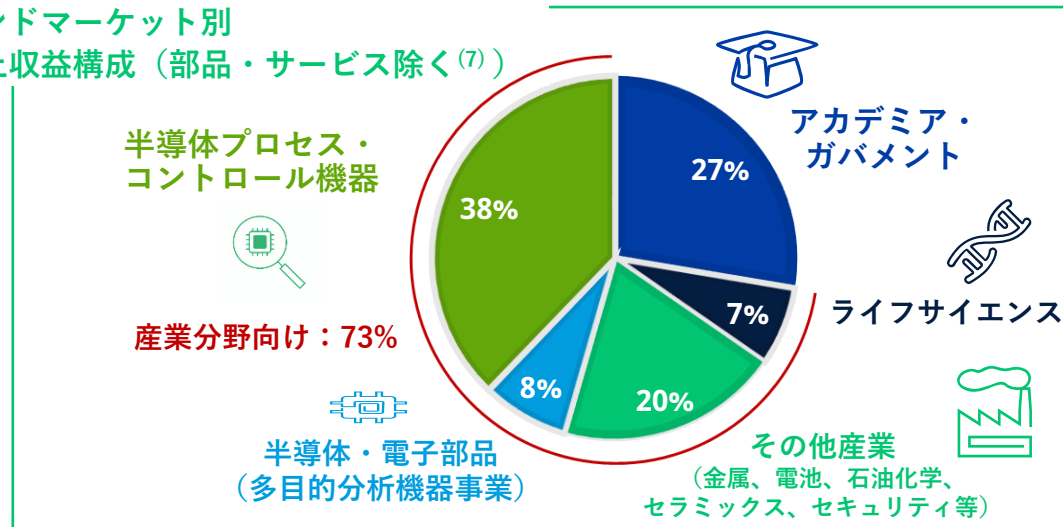
7. 部品・サービス事業の売上収益、および半導体プロセス・コントロール機器事業における部品・サービスの売上収益を除く

多様なマーケットでの事業基盤 (2025年12月期)

製品別売上収益 (外周)
営業利益 (内周)



エンドマーケット別 売上収益構成 (部品・サービス除く⁽⁷⁾)



リガクの競争優位性

- リガクの競争優位性の核は、要素部品を内製化する統合型ビジネスモデル
- 高付加価値製品の創出が可能となり、強固な顧客信頼を築き、業界トップクラスの企業との高いリテンション率を実現

要素部品の開発・製造の内製化

X線発生装置

先進的なターゲット・ローテーション技術による高いX線輝度の実現



光学素子

X線/EUV向けの先端多層膜ミラー



最適なすり合わせによる、性能の最大化

解析ソフトウェア

AIによる解析で、Metrologyに役立つ複雑構造を可視化



X線検出器

高感度X線検出器に用いられる半導体を内製



内製化によるアドバンテージ

装置の高性能化

高速計測・高分解能・省エネルギー

開発サイクルの短縮

量産効果

技術資産

- 熟練したX線技術者



研究開発者数⁽¹⁾
約300



米国特許庁に登録済の
X線関連特許数⁽²⁾
212

業界トップ企業への納入実績・高いリテンション率

半導体

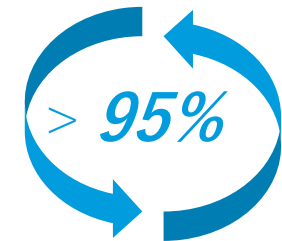
10社 / グローバル
上位10社⁽³⁾

製薬

10社 / 国内
上位10社⁽⁴⁾

化学製品

10社 / 国内
上位10社⁽⁵⁾



XRD製品とXRF製品に係る
既往顧客との更新商談における
リピート受注率⁽¹⁰⁾ (過去10年間)

注:

1. 2025年10月末時点の基礎研究／製品開発へ従事する研究開発者数

2. The United States Patent and Trademark Officeに登録されているX線関連特許数(2025年12月時点)

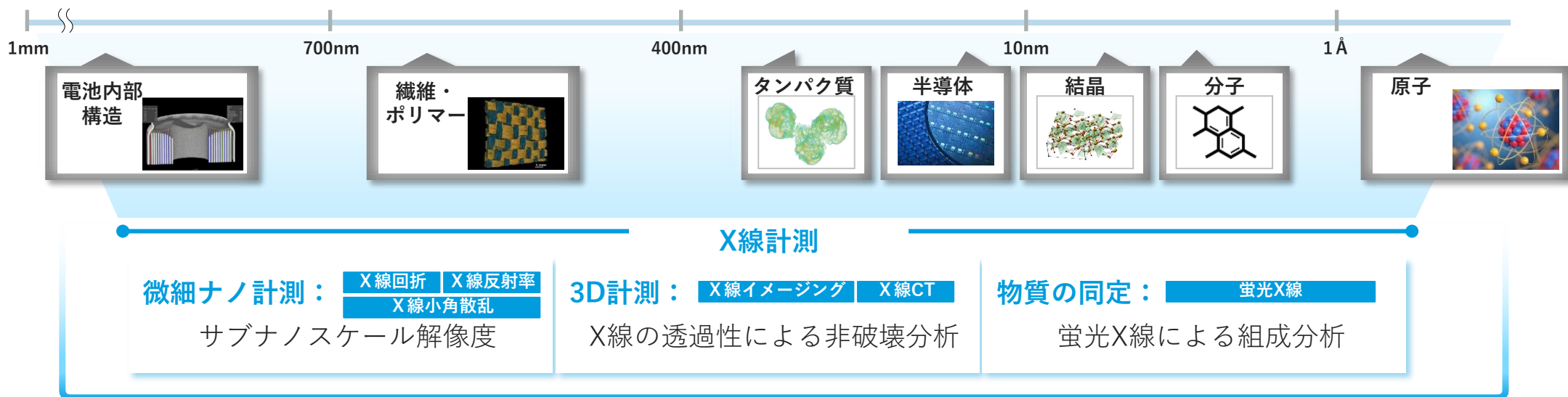
3. TechInsights, Inc.「Capital Expenditure Forecast June 2024」

4. 東証上場株価指数において「医薬品」に分類される企業の2023年売上収益ランキングに基づく

5. 東証上場株価指数において「化学」に分類される企業の2023年売上収益ランキングに基づく

不可視の世界を可視化する：リガクのX線ソリューション

■ リガクはX線独自の計測ソリューションを確立し、微細領域の検査・計測需要の高まりを中心とした、多様な分析ニーズに対応



<p>X線回折</p> <p>XRTmicron MiniFlex SmartLab</p>			<p>X線イメージング・X線CT</p> <p>CT Lab HR160 CT Lab HV</p>		<p>蛍光X線</p> <p>ZSX Primus IV Qualana</p>		<p>蛍光X線・X線回折・X線反射率</p> <p>WaferX 310</p>
---	--	--	--	--	--	--	---

エンドマーケット別当社主要製品 (多目的分析機器事業)

■ アカデミア・ガバメント

基礎研究・材料解析

- ✓ X線回折 (XRD)



大学・研究開発機関



SmartLab



MiniFlex

■ 半導体・電子部品

〈半導体〉

組成分析・信頼性評価

- ✓ 熱分析／蛍光X線 (XRF)



半導体・薄膜



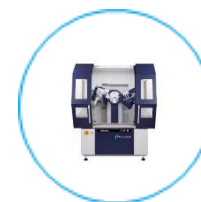
ZSX Primus IV



CT Lab HV



電池



SmartLab



ZSX Primus IV

〈電池〉

結晶構造・ナノ構造解析

- ✓ X線回折 (XRD)
- ✓ 蛍光X線 (XRF)
- ✓ 小角X線散乱 (SAXS)

■ ライフサイエンス

医薬品・生体構造解析

- ✓ X線回折 (XRD)
- ✓ 電子密度トポグラフィー



医薬品



XtaLAB
Synergy-ED



MoleQlyze

■ その他産業

原材料の組成・品質管理

- ✓ 蛍光X線 (XRF)
- ✓ X線回折 (XRD)



金属



石油・天然ガス



セラミックス



ZSX Primus IV



MiniFlex

■ 半導体製造工程で求められる高度な検査・計測ソリューションを提供するリガクの製品は先端半導体の製造に不可欠

薄膜・レジストの膜厚測定



- 組成・結晶性測定を含む
- 薄膜化・多層化に伴うサブナノ測定ニーズが増大

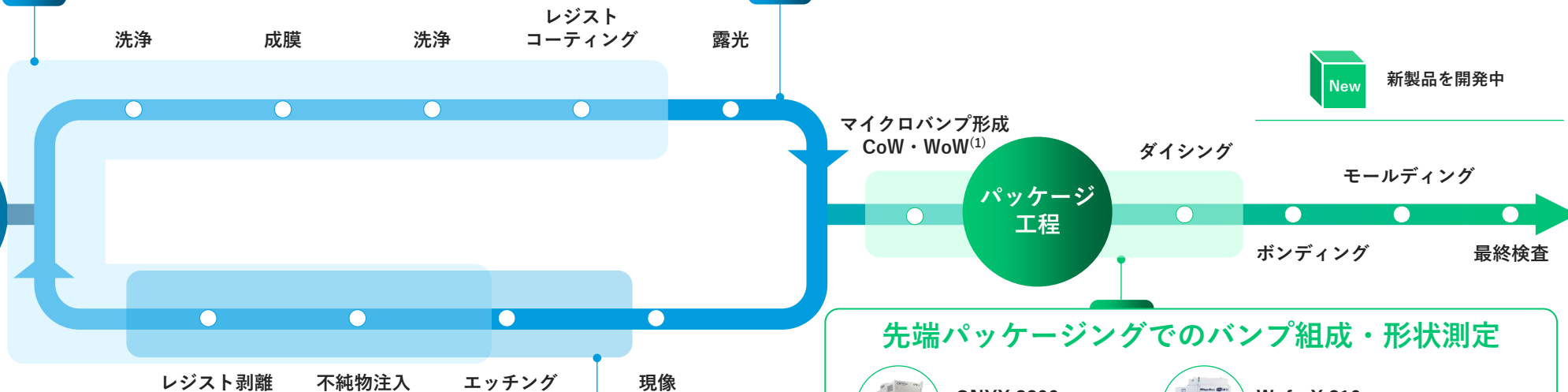
表面金属汚染分析



- 前工程の各フェーズにおける表面汚染分析

ウエハ
製造工程

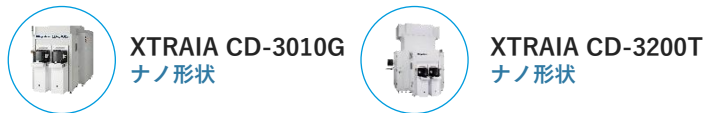
素子・配線
形成工程



多目的分析機器



膜厚、レジスト・ハードマスクの形状分析



- GAA構造にも対応する非破壊での内部構造評価、先端メモリ向けの非破壊での深穴形状測定ニーズ等を捕捉

先端パッケージングでのバンプ組成・形状測定



- 汚染や異物、傷等の検査
- チップレット集積で増加する配線・電極・バンプの膜厚・組成
- TSV⁽²⁾欠陥検査
- CoWoS・HBM等先端ソリューションにも対応

注：
1. CoW = Chip on Wafer, WoW = Wafer on Wafer
2. TSV = Through-silicon Via

リガクの成長戦略コンセプト (3本の矢)

- アプリケーション毎に最先端の計測需要に対応するソリューションを確立し、Lab to Fab戦略の推進により中長期成長を企図

Pillar1 基盤戦略の強化

多目的分析機器

多目的分析機器における先端X線分析
ソリューションへの需要の高まり

Pillar2 半導体でのLab to Fab戦略の推進

半導体プロセス・コントロール機器

半導体産業の発展に
必要不可欠なX線技術

Pillar3 Lab to Fab戦略の拡大展開

多目的分析機器

新たなアプリケーションの
開発による新市場の創出

基本戦略

- イノベーションが活発な産業分野へのLab to Fab戦略の拡大・多目的分析機器のFab仕様化

- Lab to Fab戦略を強力に推進し、半導体X線計測市場におけるグローバルリーダー
- 半導体の微細化・積層化に対応する新しいソリューションの提供で事業領域を拡大

- 卓越したX線要素技術力と強固な顧客基盤をレバレッジに、多様化・高度化する顧客のR&Dニーズに対応
- 海外コマース・インフラに積極投資を行い、グローバル市場でシェア拡大

注力分野

- グローバルサプライチェーンの強化
- サービス事業の拡大

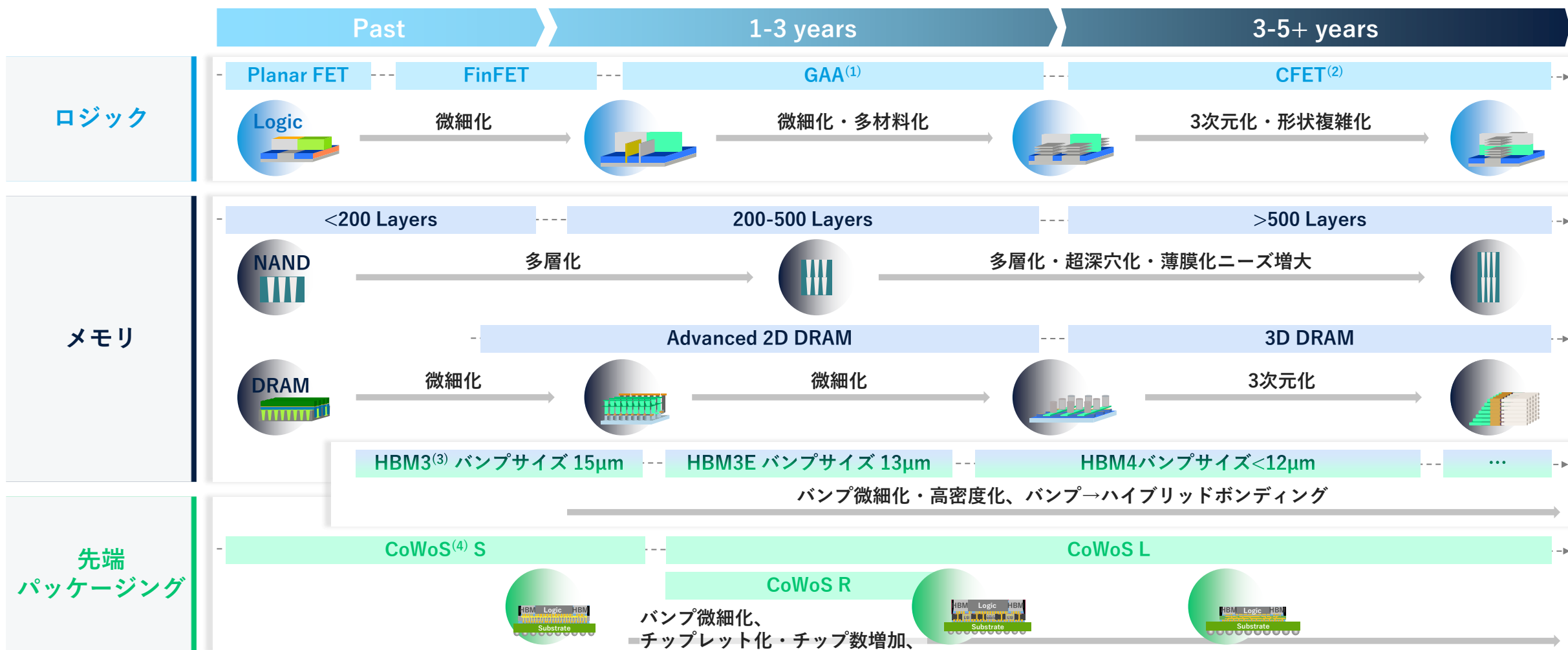
- 半導体先端技術トレンドに即したソリューション提供
- 光学・CD計測との補完により事業領域を拡大 (Hybrid Metrology)
- アドバンスド・パッケージング検査への参入

- パワーデバイス(次世代化合物半導体)
- 電池(全・半固体電池等)
- ライフサイエンス(バイオ医薬品等)

先端半導体製造における検査・計測ニーズ

■ 半導体製造工程は微細化・多材料化等による転換点を迎え、高精度検査・計測技術は一層重要に

アプリケーション別先端半導体の技術トレンド



注：
 1. GAA = Gate All Around
 2. CFET = Complementary FET
 3. HBM = High Bandwidth Memory
 4. CoWoS = Chip on Wafer on Substrate

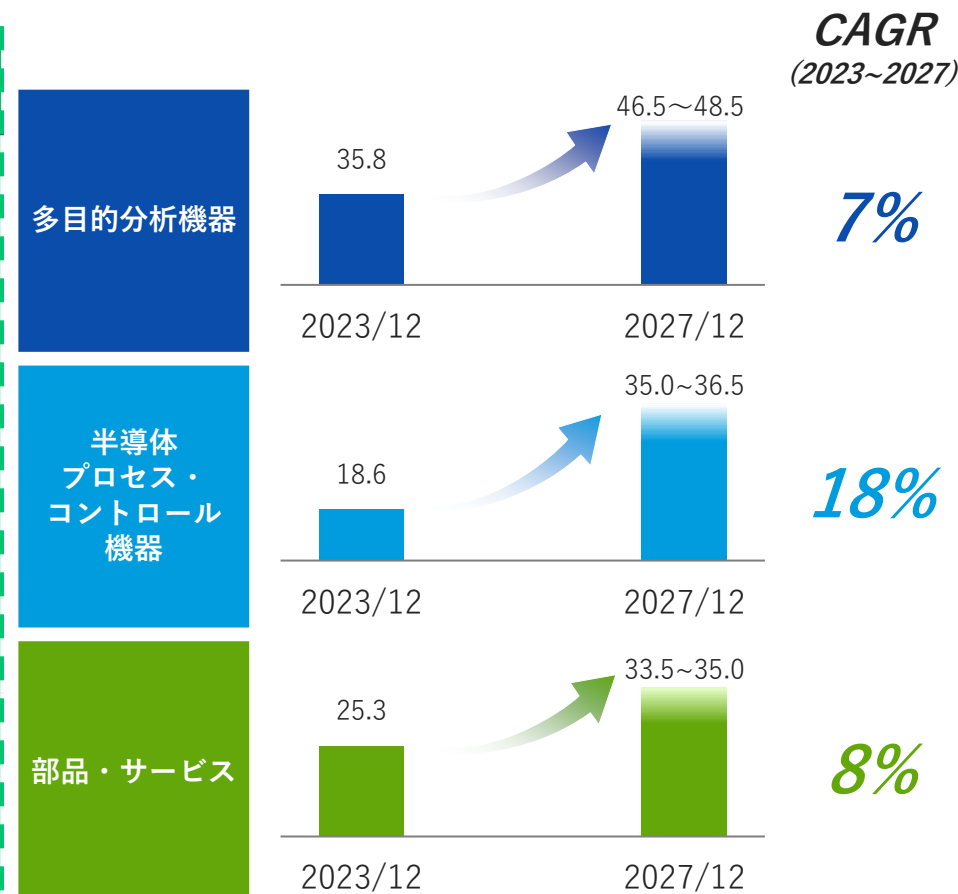
中期経営計画

■ 半導体プロセス・コントロール機器の力強い成長により、売上高年平均成長率（CAGR）約10%を目指す

中期計画目標値（全社）

製品カテゴリー別売上高成長目標（億円）

	中計基準年度 (2023年12月期)	2025年12月期 (実績)	2026年12月期 (予想)	中期計画目標 (2027年12月期)
売上収益 (YoY)	798億円 27.4%	941億円 3.9%	1,010億円 7.2%	1,150~1,200億円 ⁽¹⁾ (CAGR約10%)
調整後EBITDA ⁽²⁾ Margin	202億円 25.3%	218億円 23.0%	253億円 25.3%	315~325億円 約27%
調整後営業利益 ⁽³⁾ Margin	152億円 19.0%	186億円 19.8%	215億円 21.3%	265~275億円 約23%
株主還元	-	18.8円/株	19.0円/株	配当性向 約30%
研究開発費比率 ⁽⁴⁾	6.5%	7.8%	8.5%	約9%
設備投資額比率 ⁽⁵⁾	3.5%	7.1%	7.7%	約5% ⁽⁶⁾
要員数 ⁽⁷⁾	1,994人	2,226人	2,351人	2,500~2,600人



注：

1. レンジ幅は売上収益の中期計画目標の5%の範囲内に設定（調整後EBITDA、調整後営業利益及び要員数のレンジ幅についてもそれぞれ同様）。売上収益の中期計画目標におけるYoY成長率は、2023年12月期を基準とする2027年12月期までの4ヶ年における売上収益の年平均成長率で、2025年12月期から2027年12月期までの各期の売上収益は想定為替レートを1ドル145円、1ユーロ156円として算出

2. EBITDA = 税金等調整前当期利益 + 減価償却費及び償却費 + 減損損失 - 受取利息及び配当金 + 支払利息 EBITDA率 = EBITDA / 売上収益

3. 営業利益率 = 営業利益 / 売上収益

4. 研究開発費比率 = 研究開発費 / 売上収益

5. 設備投資額比率 = 設備投資額 / 売上収益 設備投資額は使用権資産を除いた設備投資の金額により算出

6. 2027年12月期の設備投資額比率目標は、その分子となる設備投資額に現在時点で計画されていない山梨工場に続く大型の工場改修・増強投資を含まない

7. 要員数は年度末の就業人数と年度平均の臨時雇用人数の合計により表示

用語集

用語	説明
AXI	<ul style="list-style-type: none">Automated X-Ray Inspectionの略称。X線を用いた自動検査装置。電子基板や半導体内部の欠陥を非破壊で検出し、品質管理を効率化する
CFET	<ul style="list-style-type: none">Complementary FET(CFET)は、N型FETとP型FETを垂直方向に積層して統合する次世代の半導体デバイス技術 現在主流のFinFETやGAA(Gate-All-Around)FETに続く技術として期待されている
CoWoS	<ul style="list-style-type: none">Chip on Wafer on Substrateの略称。TSMCが開発した先進パッケージ技術の一つ。 複数のチップをシリコンインターポザー上に実装し、基板に搭載することで、高速・大容量のデータ処理と省スペース化を実現
DicifferX WAXS Edition	<ul style="list-style-type: none">高分子フィルム、繊維、薄膜などの材料における原子・分子構造、結晶相および分子配向を高精度かつ数秒以内に測定する先進的なX線分析装置
Electron Density Topography (電子密度トポグラフィー)	<ul style="list-style-type: none">結晶内部の電子の分布(電子密度)を可視化する技術。これにより、材料の原子構造や結合の状態を詳細に調べることが可能
EUV	<ul style="list-style-type: none">Extreme Ultravioletの略称。波長が約13.5nmの紫外線を指し、半導体製造の露光プロセスで使用される光源技術
GAA	<ul style="list-style-type: none">Gate-All-Aroundの略称。 トランジスト技術の一種で、ゲートがすべての側面からチャンネルに接触、継続的な小型化を可能にするトランジスタ構造を指す
GaN	<ul style="list-style-type: none">ガリウム(Ga)と窒素(N)で構成される化合物半導体材料

用語	説明
Qualana	<ul style="list-style-type: none">高い分析精度を備え、位置ずれのない微小領域および広域マッピングを高精度に実現する先進的なX線分析装置。軽元素までも高感度で検出し、リガク独自のFPプログラムにより、柔軟な薄膜定量分析をサポート
SiC	<ul style="list-style-type: none">シリコン(Si)と炭素(C)で構成される化合物半導体材料
SiGe	<ul style="list-style-type: none">シリコン(Si)にゲルマニウム(Ge)で構成される合金半導体材料
TFXRD	<ul style="list-style-type: none">半導体産業における薄膜特性の高精度な評価を目的としたX線回折(XRD)装置。特に、200mmおよび300mmの大口径ウェーハ上の薄膜の測定に対応しており、研究開発から製造プロセスのモニタリングまで幅広く利用されている
T-SAXS	<ul style="list-style-type: none">Transmissive Small-Angle X-ray Scatteringの略称。透過型小角X線散乱法。物質にX線を透過させ、その散らばり方を分析することで、物質内部のナノメートルスケールの微細構造を非破壊で解析できる手法。半導体部品内部の微細な状態を詳しく確認する際に用いられる
WFE	<ul style="list-style-type: none">Wafer Fab Equipmentの略称。ウェーハを回路形成・検査するプロセスにおける製造装置を指す
X線CT	<ul style="list-style-type: none">X線コンピュータ断層撮影(CT)は、対象物の密度分布を3Dで非破壊的にスキャンし、内部構造を明らかにするX線イメージング技術
XRD(回折)	<ul style="list-style-type: none">X線回折(XRD)。結晶試料にX線を照射するときに生じる回折パターンから試料の結晶構造情報を得る手法

用語	説明
XRF (蛍光)	<ul style="list-style-type: none">• X-Ray Fluorescenceの略称。物質にX線を照射したときに発生する蛍光X線を利用して、定性分析や定量分析を行う元素分析手法
XRTmicron	<ul style="list-style-type: none">• 高輝度X線光源と専用光学系を用いた高分解能・高速X線トポグラフィ装置。 Si、SiC、GaNなどの単結晶材料に対応。結晶欠陥を非破壊、全自動で検出できることから、半導体生産の歩留まり向上に寄与できる
XtaLAB Synergy ED	<ul style="list-style-type: none">• リガクの単結晶X線構造解析の要素技術と日本電子の透過型電子顕微鏡の要素技術を組み合わせて作られた電子線回折装置。 従来よりも微細な粉末状の結晶でも測定が可能。これまで解析が困難であった物質でも構造情報を得ることができる
ZSX Primus III NEXT	<ul style="list-style-type: none">• 定評のある上面照射型の走査型X線分析装置。生産管理で広く使われてきた汎用モデル「ZSX PrimusIII+」の後継機
ZSX Primus IV	<ul style="list-style-type: none">• 4kWの強力なX線を用いて、物質に含まれる元素を詳しく調べる波長分散型のX線分析装置



免責事項

本プレゼンテーションに含まれる将来見通し、計画、戦略などは、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、リスクや不確実性を含んでいます。実際の業績は、経済情勢や市場動向などの要因により、これらの見通しとは大きく異なる可能性があります。本資料は、当社株式の購入や売却を勧誘するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。本プレゼンテーションの内容は予告なく変更または削除される場合があります。また、本資料の利用により生じたいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。